Procedimiento para la obtención de películas de materiales semiconductores incorporando una banda intermedia

Información de contacto

Dirección: Principales:

- ANTONIO MARTI VEGA

antonio.marti@upm.es

- ANTONIO LUQUE LOPEZ

a.luque@upm.es

Otros inventores:

- LuisCastañer Muñoz UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

Tipo de oferta tecnológica

[Patentes](#)

¿Dónde?

[Instituto de Energía Solar \(IES\) Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares](#)

Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=144&id_archivo=320&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

Descripción de la patente

La presente invención describe un procedimiento de obtención de películas delgadas de materiales semiconductores de banda intermedia consistente en la obtención de un blanco de partículas prensadas del dicho material para utilizarlo en un equipo de pulverización catódica. El blanco se obtiene mediante el proceso térmico de una mezcla de los componentes del material semiconductor, siguiendo un perfil específico de temperaturas y tiempos, para conseguir un material en forma policristalina de la misma composición que el material semiconductor de banda intermedia. El material policristalino se desagrega mediante procedimientos mecánicos nuevamente en forma de polvo y se compacta posteriormente, mediante la aplicación de presión en forma adecuada para formar un blanco.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P200800571

Número de publicación

ES2302663

Fecha de presentación

28/02/2008

Fecha de concesión

16/01/2009